

主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移(案)

(暦年:2007年~2011年)

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会  
特殊ガス企画委員会  
単位:kg

番号	ガス名称	化学記号	2007年 (平成19年)		2008年 (平成20年)		2009年 (平成21年)		2010年 (平成22年)		2011年 (平成23年)	
			需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比
1	アルシン	AsH3	20,200	100%	21,400	106%	15,600	73%	20,600	132%	16,400	80%
2	ジボラン	B2H6	630	100%	590	94%	430	73%	480	112%	540	113%
3	三塩化ホウ素	BCl3	92,000	100%	98,000	107%	101,100	103%	123,600	122%	120,700	98%
4	四フッ化炭素	CF4	494,000	104%	489,000	99%	357,500	73%	475,900	133%	494,900	104%
5	三フッ化メタン	CHF3	73,800	109%	85,200	115%	73,400	86%	86,100	117%	79,800	93%
6	六フッ化エタン	C2F6	390,000	86%	343,300	88%	206,500	60%	247,900	120%	227,300	92%
7	八フッ化シクロブタン	C4F8	27,000	108%	29,000	107%	40,700	140%	43,700	107%	48,200	110%
8	塩素	Cl2	185,000	112%	203,000	110%	172,900	85%	247,300	143%	347,800	141%
9	ゲルマン	GeH4	110	110%	120	109%	110	92%	110	100%	240	218%
10	臭化水素	HBr	72,200	118%	83,000	115%	74,900	90%	94,300	126%	106,700	113%
11	アンモニア	NH3	1,132,000	110%	1,168,000	103%	979,400	84%	1,589,600	162%	2,488,200	157%
12	三フッ化窒素	NF3	1,168,000	132%	1,423,000	122%	1,232,600	87%	1,658,200	135%	1,637,600	99%
13	一酸化二窒素	N2O	610,000	112%	580,000	95%	490,700	85%	603,400	123%	593,400	98%
14	ホスフィン	PH3	18,400	102%	17,700	96%	11,700	66%	15,800	135%	12,400	78%
15	モノシラン	SiH4	349,000	109%	407,000	117%	430,300	106%	547,500	127%	541,900	99%
16	ジシラン	Si2H6	500	100%	500	100%	550	110%	580	105%	*1	
17	ジクロロシラン	SiH2Cl2	144,000	115%	155,000	108%	130,000	84%	160,000	123%	172,900	108%
18	四フッ化ケイ素	SiF4	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	5,700	95%	5,700	100%
19	TEOS	(C2H5O)4Si	342,000	167%	378,000	111%	390,600	103%	424,500	109%	407,700	96%
20	六フッ化硫黄	SF6	197,000	103%	207,000	105%	186,300	90%	267,400	144%	267,400	100%
21	六フッ化タングステン	WF6	78,000	115%	86,000	110%	90,000	105%	108,000	120%	103,000	95%
22	有機金属		1,500	100%	1,750	117%	1,610	92%	2,470	153%	4,600	186%
23	その他ガス	H2Se BF3、Si2H6 SiHCl3等										
年間需要金額(単位:億円)			515	108%	552	117%	497	90%	603	121%	645	107%

(注) \*1 ジシラン:2011年よりその他ガス欄に移行